

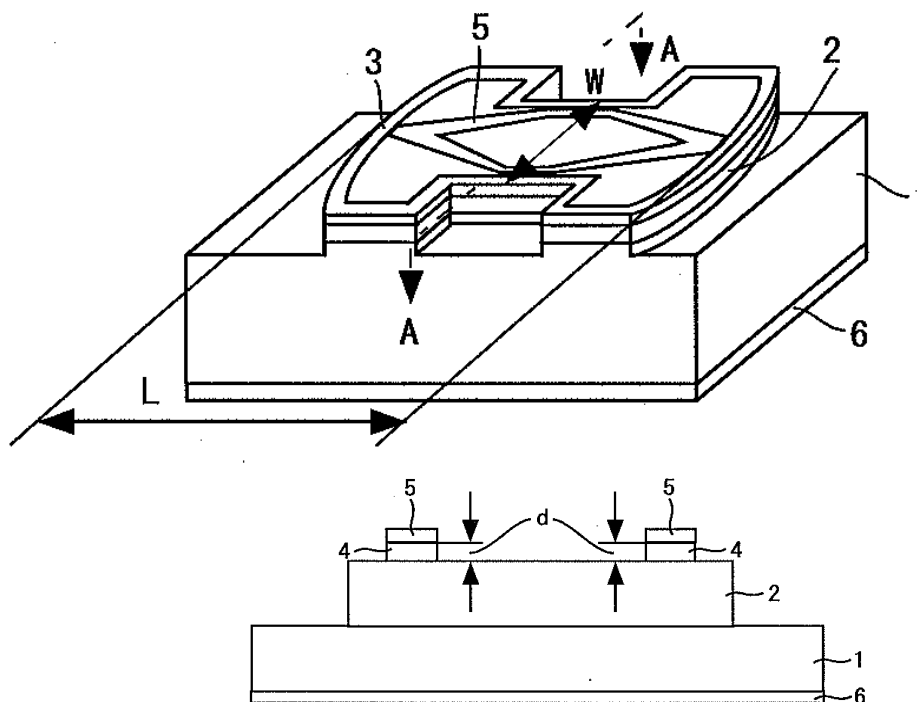
技術の名称

# 半導体レーザー

適用分野

## 半導体レーザー、 共振モードが切り替え可能な半導体レーザー

- 目的 レーザ発振のためのしきい値電流を低減すると共に発振モードの切り替えが容易な半導体レーザーを提供する。
- 効果 本発明によれば、正極からキャビティへ注入される注入電流の拡がりgstライプ層によって抑制されるので、レーザー発振のためのしきい値電流が低減され、またその結果、シングルモード、ツインモード並びにロッキングモードの切り替えるための電流が少なくて済み、発振モードの切り替えが容易となる。
- 技術概要 本発明に係る半導体レーザーは、基板1上に設けられたキャビティ2にはレーザー光を出射する活性層を含んでおり、キャビティ2上にはリング形状のストライプ層4並びにそのストライプ層4上にリング形状の正極5が形成されていて、ストライプ層4は正極5からキャビティ2へ注入された注入電流の拡がりを抑制している。
- 特記事項、  
図など



- 主たる提供  
特許 特許等の名称 : 半導体レーザーおよびその製造方法  
登録番号 :  
出願番号 : 特願2007-284877 出願日 : 平成19年11月1日  
公開番号 :
- 実施実績 有、 ○無 ■ 提供形態 ○実施許諾、 ×権利譲渡

お問合せ先

株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 (ATR) 経営統括部 知的財産チーム  
〒619-0288 京都「けいはんな学研都市」光台二丁目2番地2  
TEL 0774-95-2521 E-mail ; patent@atr.jp